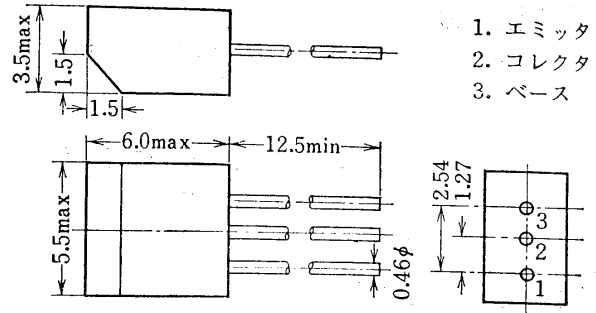


2SC455

シリコン NPN
エピタキシャルプレーナ形
AMラジオ高周波増幅用



■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
許容コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

	最小	標準	最大
コレクタ・ベース破壊電圧 BV_{CBO} ($I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$)	30	—	— V
コレクタ・エミッタ破壊電圧 BV_{CEO} ($I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$)	30	—	— V
エミッタ・ベース破壊電圧 BV_{EBO} ($I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$)	5	—	— V
コレクタ遮断電流 I_{CBO} ($V_{CB}=18\text{V}, I_E=0$)	—	—	0.5 μA
エミッタ遮断電流 I_{EBO} ($V_{EB}=2\text{V}, I_C=0$)	—	—	0.5 μA
直流電流増幅率*			
h_{FE} ($V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$)	22	—	70
コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ ($I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$)	—	0.15	1.1 V
ベース・エミッタ電圧 V_{BE} ($V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$)	—	0.63	0.75 V
利得帯域幅積 f_T ($V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$)	—	230	— Mc
雑音指数 NF ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$) ($f=1\text{kc}, R_g=500\Omega$)	—	—	25 dB
雑音指数 NF ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=2\text{mA}$) ($f=1\text{Mc}, R_g=50\Omega$)	—	4	5.5 dB

2SC455

コレクタ出力容量

C_{ob} ($V_{CB}=10V, I_E=0, f=1Mc$)..... — 2.5 3.5 pF

高周波電力利得

RFG ($V_{CE}=12V, I_C=2mA, f=1.5Mc$
 $R_g=200\Omega, R_L=20k\Omega$)..... — 35 — dB

* 2SC455 は h_{FE} により下記のように区分し、現品にそれぞれ ①, ② と表示してあります。

	①	②
h_{FE}	22~45	35~70

■各特性曲線は 2SC460, 461 参照.